

高斯定理:

在真空中静电场, 穿过任意**闭合曲面**的电场强度通量, 等于该闭合曲面所包围的所有电荷的代数和除以 ε_0 。

点电荷系

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i^{in}$$

连续分布带电体

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \int dq$$

1、利用高斯定理求场强的条件:

电荷分布必须具有一定的对称性。

2、利用高斯定理求场强步骤:

1) 进行**对称性分析**。由电荷分布对称性→场强分布对称性。

球对称性 (均匀带电球面、球体、球壳、多层同心球壳等)

轴对称性 (均匀带电无限长直线、圆柱体、圆柱面等)

面对称性 (均匀带电无限平面、平板、平行平板层等)



2) 合理选取**高斯面**，使通过该面的电通量易于计算。

球对称性：球面

轴对称性：圆柱面

面对称性：圆柱面

3) 计算**高斯面内包围的电荷的电量**（带电体要用微积分）。

4) 用高斯定理求场强。

3、高斯面的选法：

a、高斯面一定要通过待求场强的场点。

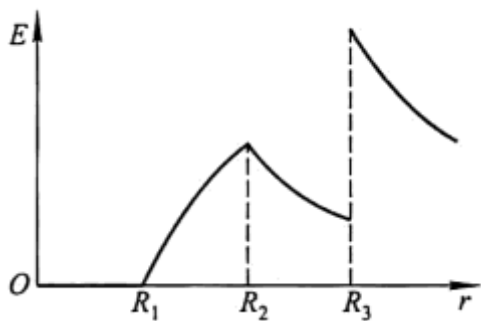
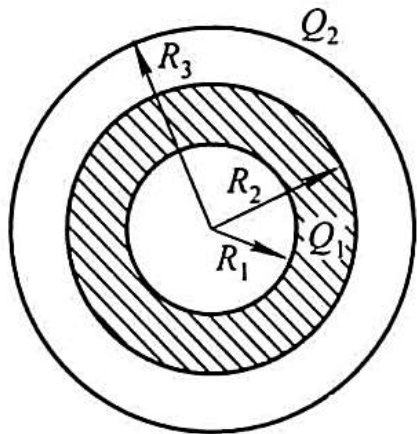
b、高斯面的各部分要与场强垂直或者与场强平行。

与场强垂直的那部分上的各点的场强要相等。

c、高斯面的形状应尽量简单。



P204 5-22 一个内外半径分别为 R_1 和 R_2 的均匀带电球壳，总电荷为 Q_1 ，球壳外同心罩一个半径为 R_3 的均匀带电球面，球面带电荷为 Q_2 。求电场分布；电场强度是否为离球心距离 r 的连续函数？试分析。



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i^{\text{in}} \quad E 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i^{\text{in}}$$

解： 取半径为 r 的同心球面为高斯面 $E 4\pi r^2 = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$

$r < R_1$ ，该高斯面内**无电荷**， $\sum q = 0$ ，故 $E_1 = 0$

$R_1 < r < R_2$ ，高斯面内电荷 $\sum q = \frac{Q_1(r^3 - R_1^3)}{R_2^3 - R_1^3}$ ，

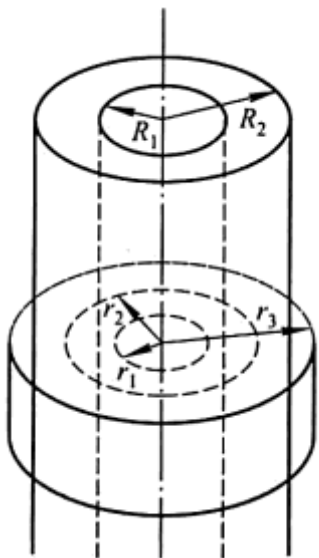
$$E_2 = \frac{Q_1(r^3 - R_1^3)}{4\pi\epsilon_0(R_2^3 - R_1^3)r^2}$$

$R_2 < r < R_3$ ，高斯面内电荷为 Q_1 ， $E_3 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

$r > R_3$ ，高斯面内电荷为 $Q_1 + Q_2$ ， $E_4 = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$



P205 5-24 两个带有等量异号电荷的无限长同轴圆柱面，半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$)，单位长度上的电荷为 λ 。求离轴线为 r 处的电场强度：(1) $r < R_1$ ，(2) $R_1 < r < R_2$ ，(3) $r > R_2$ 。



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i^{\text{in}} \quad E 2\pi r l = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i^{\text{in}}$$

解： 作同轴圆柱面为高斯面，根据高斯定理 $E 2\pi r L = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$

$r < R_1$ ，该高斯面内**无电荷**， $\sum q = 0$ ，故 $E_1 = 0$

$R_1 < r < R_2$ ，高斯面内电荷 $\sum q = \lambda L$ ，

$$E_2 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$r > R_2$ ，高斯面内电荷 $\sum q = 0$ （等量异号电荷），

$$E_3 = 0$$

$$= \frac{\sum q}{\epsilon_0}$$



电势的计算

(1) 利用定义式:

$$V_A = \int_A^{\text{电势零点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

已知在积分路径上 \vec{E} 的函数表达式

电荷分布在有限区域, 取**无穷远处**为电势零点,
电荷分布在无限区域, 取**有限区域内一点**为电势零点。

(2) 利用电势的叠加原理

电荷系:

$$V_A = \sum_{i=1}^n V_i$$

带电体:

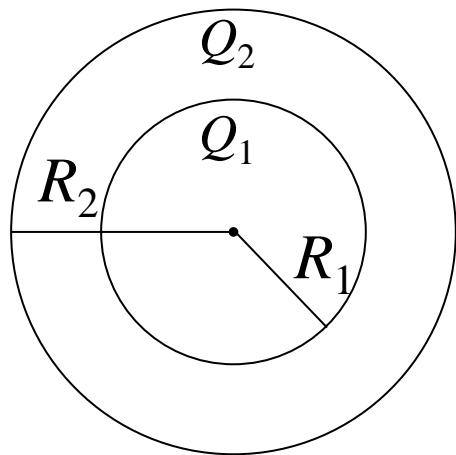
$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$$

◆ 电势差

$$U_{AB} = V_A - V_B = \int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



P205 5-30 两个同心球面的半径分别为 R_1 和 R_2 ，各自带有电荷 Q_1 和 Q_2 。求：(1) 各区域电势的分布，并画出分布曲线；(2) 两球面上的电势差？



$$V_A = \int_A^{\text{电势零点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$(r \leq R_1)$

$$\begin{aligned} V_1 &= \int_r^{R_1} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_{R_1}^{R_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \int_{R_2}^{\infty} \vec{E}_3 \cdot d\vec{l} \\ &= 0 + \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \\ &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \end{aligned}$$

(1) 由高斯定理可求得电场分布：

$(R_1 \leq r \leq R_2)$

$$E_1 = 0 \quad (r < R_1)$$

$$E_2 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \quad (R_1 < r < R_2)$$

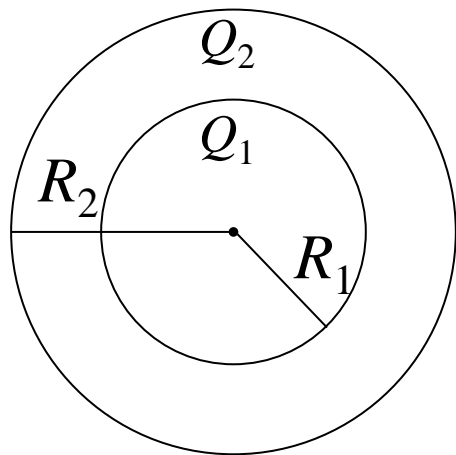
$$E_3 = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \quad (r > R_2)$$

$$\begin{aligned} V_2 &= \int_r^{R_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \int_{R_2}^{\infty} \vec{E}_3 \cdot d\vec{l} \\ &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \\ &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \end{aligned}$$

5-22 同心球壳换为同心球面



P205 5-30 两个同心球面的半径分别为 R_1 和 R_2 ，各自带有电荷 Q_1 和 Q_2 。求：(1) 各区域电势的分布，并画出分布曲线；(2) 两球面上的电势差？

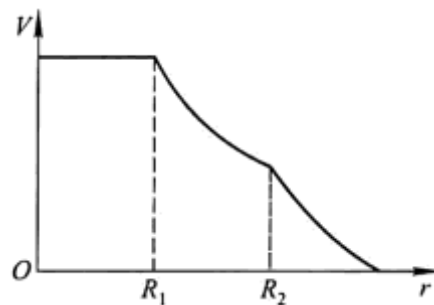


$$(r \leq R_1) \quad V_1 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$V_A = \int_A^{\text{电势零点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$(R_1 \leq r \leq R_2) \quad V_2 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$(r \geq R_2) \quad V_3 = \int_r^\infty \vec{E}_3 \cdot d\vec{l} = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$$



(1) 由高斯定理可求得电场分布：

$$E_1 = 0 \quad (r < R_1)$$

$$E_2 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$E_3 = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r \quad (r > R_2)$$

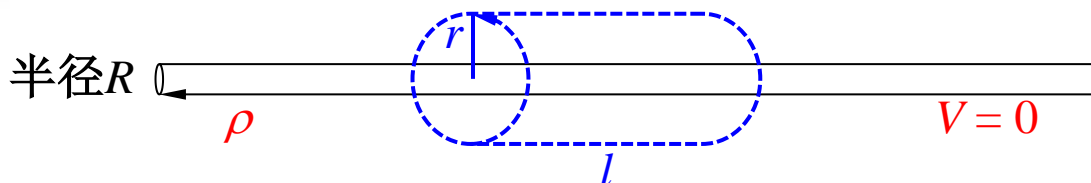
(2) 两球面上的电势差：

$$U_{12} = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

5-22 同心球壳换为同心球面



P206 5-31 一半径为 R 的无限长带电细棒，其内部的电荷均匀分布，电荷的体密度为 ρ 。现取棒表面为零电势，求空间电势分布，并画出电势分布曲线。



$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E 2\pi r l = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$$

$$V_p = \int_p^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

解：取高度为 l 、半径为 r 且与带电棒同轴的圆柱面为高斯面

$r \leq R$ ，高斯面体积为 $\pi r^2 l$ ，高斯面内电荷量 $\sum q = \pi r^2 l \rho$ ，

$$E_1 2\pi r l = \frac{\pi r^2 l \rho}{\epsilon_0} \quad E_1 = \frac{\rho r}{2\epsilon_0}$$

$r \geq R$ ，高斯面包围带电细棒，高斯面内电荷量 $\sum q = \pi R^2 l \rho$ ，

$$E_2 2\pi r l = \frac{\pi R^2 l \rho}{\epsilon_0} \quad E_2 = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r}$$

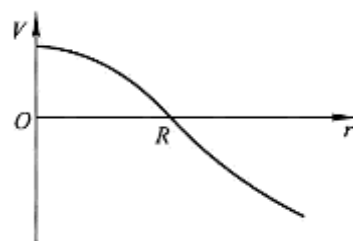
棒表面为零电势，则空间电势分布：

$$(r \leq R)$$

$$V_1 = \int_r^R \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{r} = \int_r^R \frac{\rho r}{2\epsilon_0} dr = \frac{\rho}{4\epsilon_0} (R^2 - r^2)$$

$$(r \geq R)$$

$$V_2 = \int_r^R \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{r} = \int_r^R \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r} dr = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} \ln \frac{R}{r}$$



(1) 分析自由电荷分布的对称性, 选择适当的高斯面, 求出电位移矢量:

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S_{\text{内}}} q_0$$

(2) 根据电位移矢量与电场的关系, 求出电场强度。

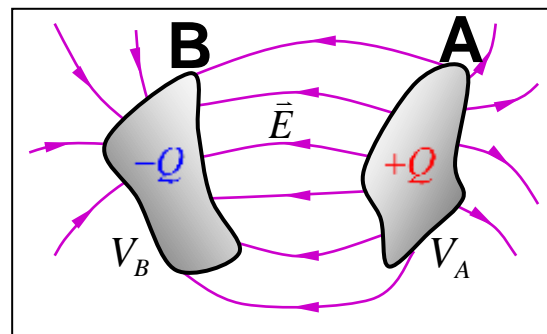
$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$$

(3) 根据电极化强度与电场的关系, 求出电极化强度。

$$\vec{P} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \vec{E}$$

(4) 根据极化电荷与电极化强度关系, 求出极化电荷。

$$\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{e}_n \quad \vec{D} \rightarrow \vec{E} \rightarrow \vec{P} \rightarrow \sigma'$$



$$C = \frac{Q}{U}$$

$$U = V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

步骤:

- (1) 设两极板分别带电 $\pm Q$
- (2) 求两极板间的电场强度 \vec{E}
一般用高斯定理
- (3) 求两极板间的电势差 U
- (4) 由 $C = Q/U$ 求 C



P244 6-24 一片二氧化钛晶片，其面积为 1.0 cm^2 ，厚度为 0.10 mm 。把平行平板电容器的两极板紧贴在晶片两侧。(1) 求电容器的电容；(2) 当在电容器的两极间加上 12 V 电压时，极板上的电荷为多少？此时自由电荷和极化电荷的面密度各为多少？(3) 求电容器内的电场强度。



(1) 二氧化钛的相对电容率 $\epsilon_r = 173$ ，有介质的平板电容器的电容：

$$C = \frac{\epsilon S}{d} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d} = 1.53 \times 10^{-9} \text{ F} \quad \text{P226 例1}$$

(2) 电容器加上 $U = 12 \text{ V}$ 的电压时，极板上的电荷：

$$Q = CU = 1.84 \times 10^{-8} \text{ C}$$

极板上的自由电荷面密度：

$$\sigma_0 = \frac{Q}{S} = 1.84 \times 10^{-8} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$$

晶体表面极化电荷面密度：

$$\sigma_0' = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \sigma_0 = 1.83 \times 10^{-4} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$$

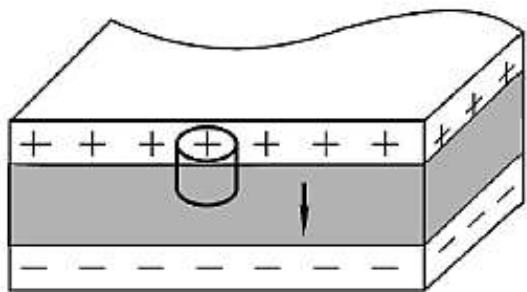
P219 6-4(a)

(3) 晶片内的电场强度：

$$E = \frac{U}{d} = 1.2 \times 10^5 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$



P245 6-27 有一个平板电容器，充电后极板上电荷面密度为 $\sigma_0 = 4.5 \times 10^{-3} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$ ，现将两极板与电源断开，然后再把相对电容率为 $\varepsilon_r = 2.0$ 的电介质插入两极板之间。此时电介质中电位移矢量 D 、电场强度 E 和极化强度 P 各为多少？



分析：由介质中的高斯定理可求得电位移矢量 D ，再根据 $D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$ ， $P = D - \varepsilon_0 E$ ，可求得电场强度 E 和电极化强度矢量 P 。

解：介质中的电位移矢量 D ：

$$\oint D \cdot dS = Q$$

$$D = \frac{Q}{S} = \sigma_0 = 4.5 \times 10^{-3} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$$

介质中的电场强度 E 和电极化强度 P ：

$$E = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = 2.5 \times 10^8 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$P = D - \varepsilon_0 E = 2.3 \times 10^{-3} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$$

D 、 P 、 E 方向相同，均由正极板指向负极板（图中垂直向下）。



毕奥—萨伐尔定律

矢量式:

$$\mathbf{d}\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \mathbf{d}\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

大小:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

方向:

$$I \mathbf{d}\vec{l} \times \vec{r}$$

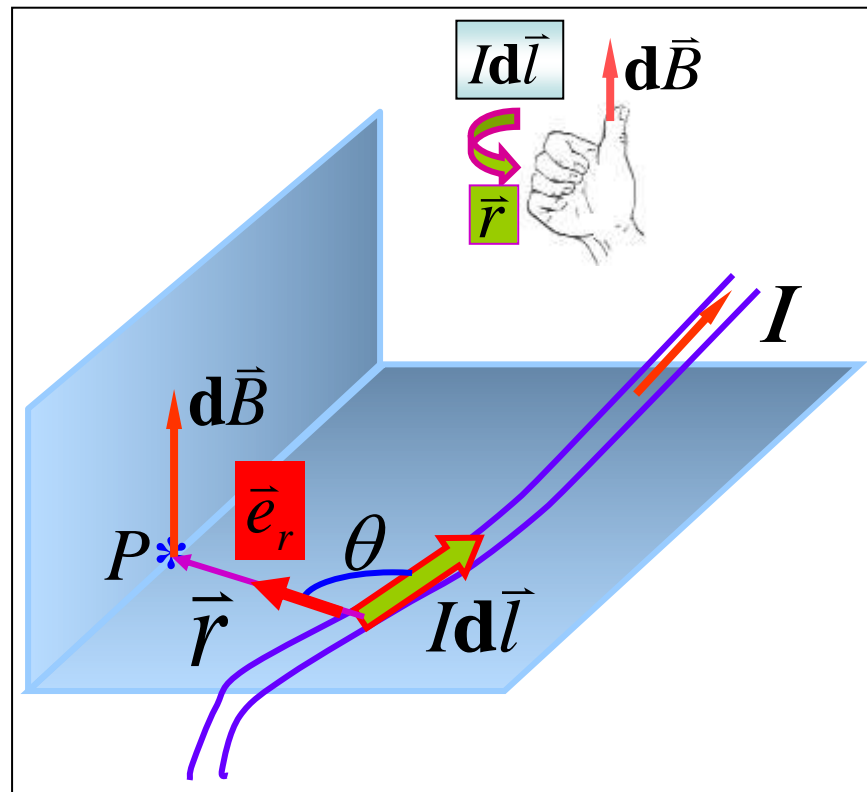
右手螺旋法则判定

◆任意载流导线在点P处的磁感强度:

$$\vec{B} = \int \mathbf{d}\vec{B} = \int \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\mathbf{d}\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

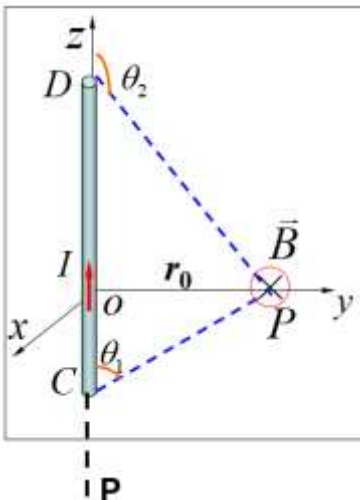
$$B_x = \int dB_x, B_y = \int dB_y$$

磁感强度叠加原理



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$



无限长载流长直导线

$$\theta_1 \rightarrow 0$$

$$\theta_2 \rightarrow \pi$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0}$$

半无限长载流长直导线

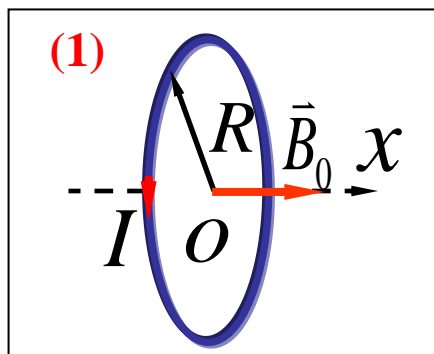
$$\theta_1 \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$\theta_2 \rightarrow \pi$$

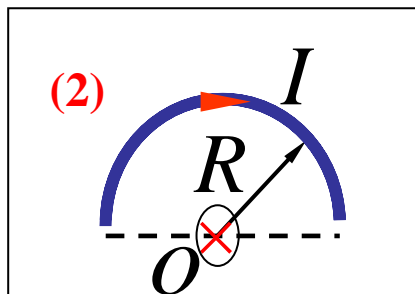
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}$$

P点位于导线延长线上, $B=0$

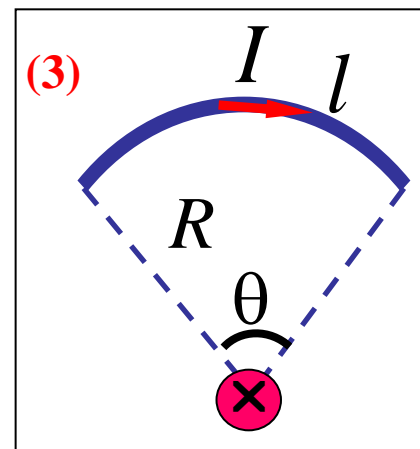
圆弧形载流导线圆心点的磁场



$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$$



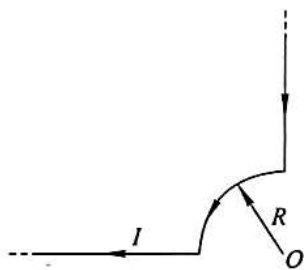
$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{4R}$$



$$B_0 = \frac{\mu_0 I \theta}{4\pi R} = \frac{\mu_0 I l}{4\pi R^2}$$



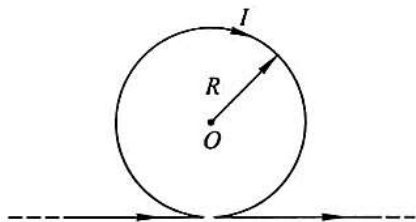
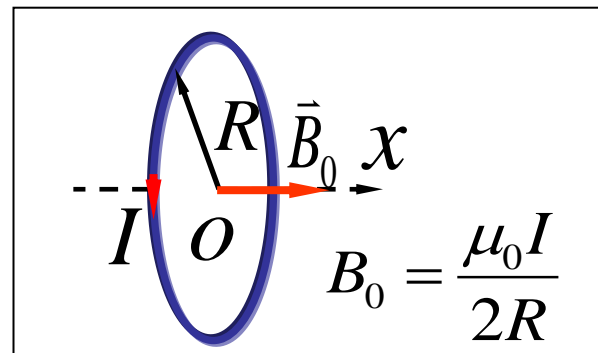
P308 7-11 如图所示，几种载流导线在平面内分布，电流均为 I ，它们在 O 点的磁感强度各为多少？。



(a)

无限长载流长直导线

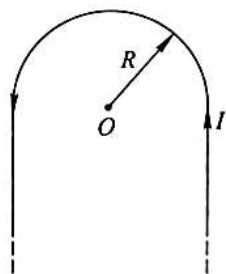
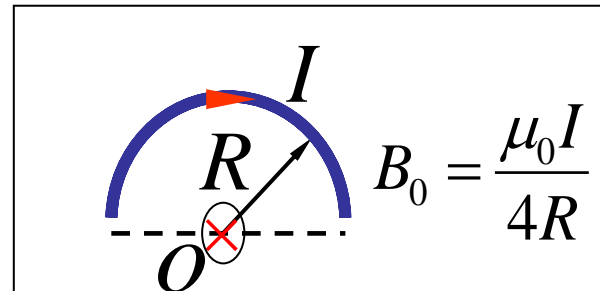
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0}$$



(b)

半无限长载流长直导线

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}$$



(c)

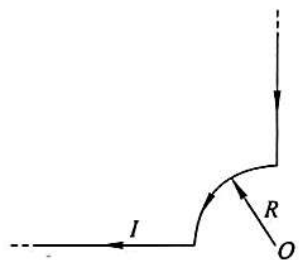
P 点位于导线延长线上, $B=0$



P308 7-11 如图所示，几种载流导线在平面内分布，电流均为 I ，它们在 O 点的磁感强度各为多少？。

(a) O 点为两长直电流延长线一点，因此两长直电流在 O 点产生的磁场为零；则 O 点总的磁感强度为1/4圆弧电流所激发：

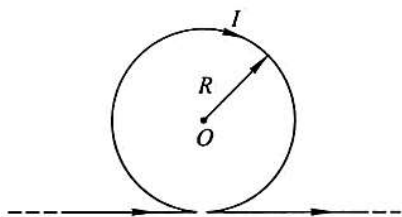
$$B = \frac{1}{4} \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{\mu_0 I}{8R} \quad B \text{ 的方向垂直纸面向外}$$



(a)

(b) 将载流导线分解为圆电流和长直电流：

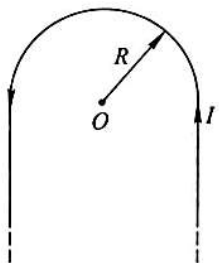
$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} - \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \quad B \text{ 的方向垂直纸面向里}$$



(b)

(c) 将载流导线分解为1/2圆电流和两段半无限长直电流：

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R} + \frac{\mu_0 I}{4R} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} + \frac{\mu_0 I}{4R}$$

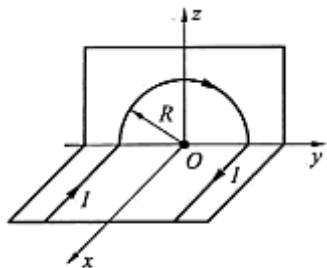


(c)

B 的方向垂直纸面向外

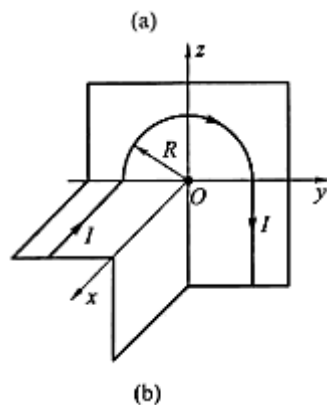


P309 7-12 载流导线形状如图所示（图中直线部分导线延伸到无穷远），求 O 点的磁感强度 B 。



(a) 将载流导线分解为1/2圆电流和两段半无限长直电流：

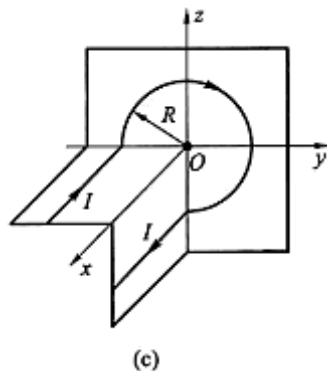
$$B = -\frac{\mu_0 I}{4R} \mathbf{i} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \mathbf{k} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \mathbf{k} = -\frac{\mu_0 I}{4R} \mathbf{i} - \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \mathbf{k}$$



(b) 将载流导线分解为1/2圆电流和两段半无限长直电流：

$$B = -\frac{\mu_0 I}{4R} \mathbf{i} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \mathbf{i} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \mathbf{k}$$

$$= -\frac{\mu_0 I}{4R} \left(1 + \frac{1}{\pi}\right) \mathbf{i} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \mathbf{k}$$



(c) 将载流导线分解为3/4圆电流和两段半无限长直电流：

$$B = -\frac{3\mu_0 I}{8R} \mathbf{i} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \mathbf{j} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \mathbf{k}$$



安培环路定理

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^n I_i$$

在真空的恒定磁场中，磁感强度 B 沿任一闭合路径的积分的值，等于 μ_0 乘以该闭合路径所包围的各电流的**代数和**。

电流 **I 正负**的规定： I 与 l 成**右**螺旋时， I 为**正**；**反**之为**负**。

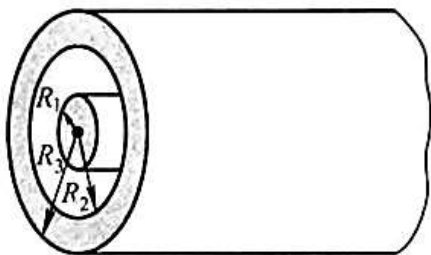
应用安培环路定理的解题步骤：

- (1) 分析磁场分布的对称性；
- (2) 过场点选择适当的路径，使得 \vec{B} 沿此环路的积分易于计算： \vec{B} 的量值恒定， \vec{B} 与 $d\vec{l}$ 的夹角处处相等。通常选取磁感线作为积分回路（**圆形，矩形**等）。
- (3) 求出环路积分；
- (4) 用右手螺旋定则确定所选定的回路包围**电流的正负**，最后由磁场的安培环路定理求出磁感应强度 \vec{B} 的大小。



P309 7-17 有一同轴电缆，其尺寸如图所示。两导体中的电流均为 I ，但电流的流向相反，导体的磁性可不考虑。试计算以下各处的磁感强度：
(1) $r < R_1$ ； (2) $R_1 < r < R_2$ ； (2) $R_2 < r < R_3$ ； (3) $r > R_3$ 。画出 B - r 图线。

安培环路定理 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B 2\pi r = \mu_0 \sum I$



解： 取半径为 r 的同心圆为积分路径

$r < R_1$ ，半径为 r 的同心圆所围面积为 πr^2 ， $\sum I = \frac{\pi r^2}{\pi R_1^2} I$

$$B_1 2\pi r = \mu_0 \frac{\pi r^2}{\pi R_1^2} I \quad B_1 = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$$

$R_1 < r < R_2$ ，半径为 r 的同心圆所围面积通电流有 $\sum I = I$

$$B_2 2\pi r = \mu_0 I \quad B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$R_2 < r < R_3$ ，半径为 r 的同心圆所围面积通电流有

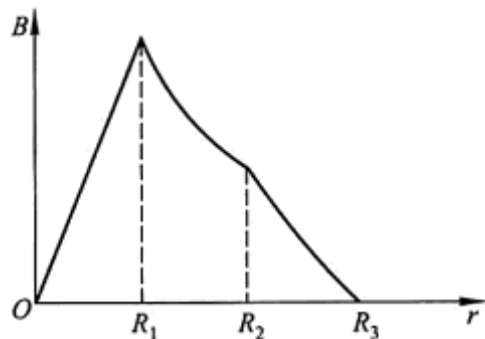
$$\sum I = \left[I - \frac{\pi(r^2 - R_2^2)}{\pi(R_3^2 - R_2^2)} I \right]$$

$$B_3 2\pi r = \mu_0 \left[I - \frac{\pi(r^2 - R_2^2)}{\pi(R_3^2 - R_2^2)} I \right] \quad B_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2}$$

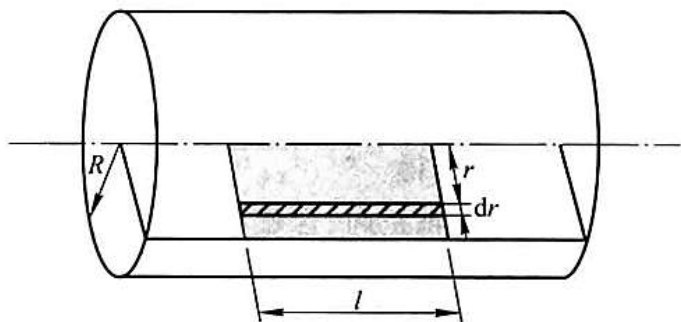
$r > R_3$ ，半径为 r 的同心圆所围面积通电流有 $\sum I = I - I$

$$B_4 2\pi r = \mu_0 (I - I) = 0$$

$$B_4 = 0$$



P310 7-20 电流 I 均匀地流过半径为 R 的圆形长直导线，试计算单位长度导线中通过图中所示剖面的磁通量。



分析：可将导线视作长直圆柱体，电流沿轴向均匀流过导体，故其磁场必然呈轴对称分布，可利用安培环路定理 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum I$ ，求出导线内部的磁感强度。

解：围绕轴线取导线内部半径为 r 的同心圆为积分路径， $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B2\pi r$ ，此时同心圆所围面积内的电流 $\sum I = \frac{\pi r^2}{\pi R^2} I$ 。

$$B2\pi r = \mu_0 \frac{\pi r^2}{\pi R^2} I \quad B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

剖面上磁感强度分布不均匀，需使用磁通量的定义 $\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$ 来求解。沿轴线方向在剖面上取面元 $dS = ldr$ ，考虑到面元上各点 \mathbf{B} 相同（ dS 为微分量，可看作面积元上各点距离轴相等），穿过面元的磁通量 $d\Phi = B dS = B l dr$ ，通过积分 $\Phi = \int d\Phi = \int B l dr = \int B dr$ （单位长度 $l=1$ ），可得单位长度导线内的磁通量。

$$\Phi = \int_0^R \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} dr = \frac{\mu_0 I}{4\pi}$$

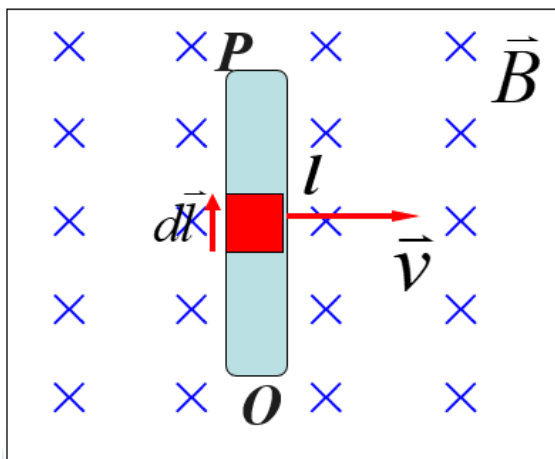


感应电动势

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} \quad \text{闭合回路由 } N \text{ 匝密绕线圈组成}$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\psi}{dt} = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

动生电动势: $\varepsilon_i = \int_O^P \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_O^P (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$



在均匀磁场中直导体以恒定速度垂直磁场运动而产生的动生电动势。

$$\varepsilon_i = vBl$$

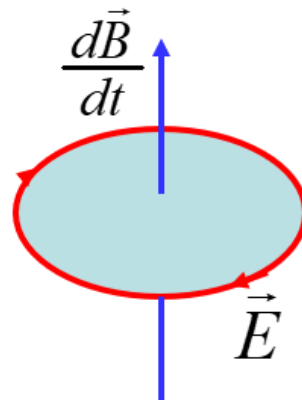
ε_i 方向 $O \rightarrow P$ (右手定则)

闭合回路中的感生电动势:

$$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

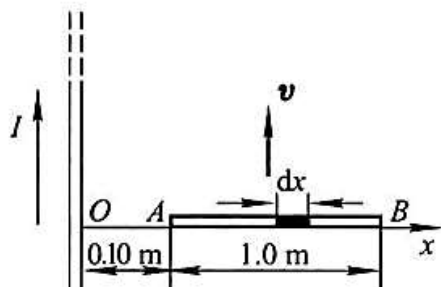
\vec{E}_k 线的绕行方向与所围的 $\frac{d\vec{B}}{dt}$ 的方向构成左螺旋关系。



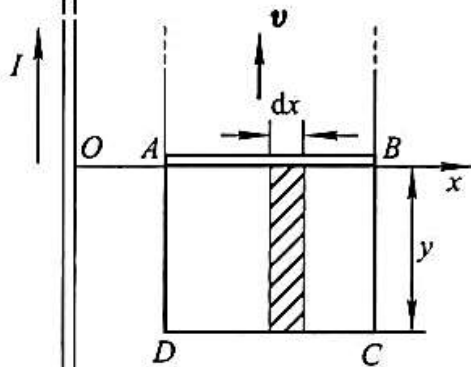
$$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{d\vec{B}}{dt} \cdot d\vec{s}$$



P349 8-13 如图所示, 金属杆 AB 以匀速率 $v=2.0 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 平行于一长直导线移动, 此导线通有电流 $I=40 \text{ A}$ 。问: 此杆中的感应电动势为多大? 杆的哪一端电势较高?



式中负号表示
电动势方向由
 B 指向 A , 故
点 A 电势较高



分析: 建立图中所示的坐标系, 取导体元 dx , 该处的磁感强度 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$, 可用公式 $\varepsilon = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$ 求解感应电动势。

解:
$$\varepsilon = \int_A^B (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = - \int_{0.1}^{1.1} \frac{\mu_0 I v}{2\pi x} dx = - \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln 11$$

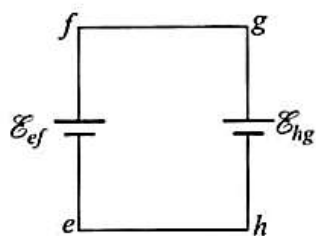
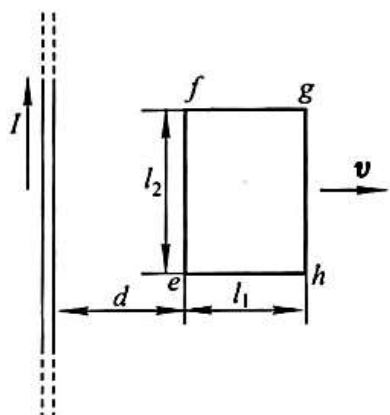
分析: 用电磁感应定律 $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$ 求解。构造包含杆 AB 在内的闭合回路。可设想杆 AB 在一个静止的矩形导轨上滑动。设时刻 t , 杆 AB 距导轨下端 CD 的距离为 y , 通过 $\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$ 求得穿过该回路的磁通量, 再由 $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$ 求得感应电动势。

解: 设顺时针方向为回路 $ABCD$ 的正向, 在距直导线 x 处, 取宽为 dx 、长为 y 的面元 dS , 则穿过面元的磁通量为

$$d\Phi = B dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} y dx \quad \Phi = \int d\Phi = \int_{0.1}^{1.1} \frac{\mu_0 I y}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 I y}{2\pi} \ln 11$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln 11 \frac{dy}{dt} = -\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln 11$$

P350 8-14 如图所示，在一无限长直载流导线的近旁放置一个矩形导体线框，该线框在垂直于导线方向上以匀速率 v 向右移动，求在图示位置处线框中的感应电动势的大小和方向。



等效电路图

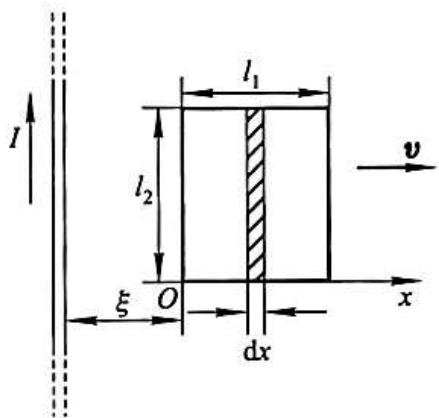
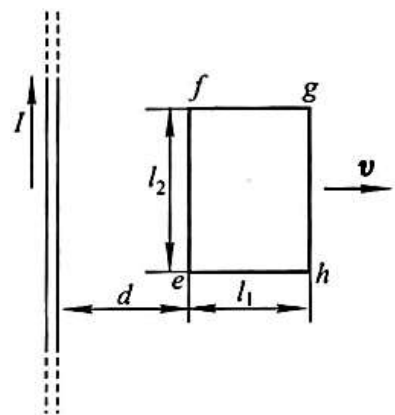
解：当闭合导体线框在磁场中运动时，线框中的总电动势就等于框上各段导体中的动生电动势的代数和。如图所示，**导体 eh 段和 fg 段上的电动势为零**（此两段导体上处处满足： $(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = 0$ ），因而线框中的总电动势为：

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \int_e^f (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} + \int_g^h (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} \\ &= \int_e^f (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} - \int_h^g (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = \varepsilon_{ef} - \varepsilon_{hg} \\ &= \int_0^{l_2} \frac{\mu_0 I v}{2\pi d} dl - \int_0^{l_2} \frac{\mu_0 I v}{2\pi(d + l_1)} dl \\ &= \frac{\mu_0 I v l_1 l_2}{2\pi d(d + l_1)}\end{aligned}$$

由 $\varepsilon_{ef} > \varepsilon_{hg}$ 可知，线框中的电动势方向为 $efgh$ 。



P350 8-14 如图所示, 在一无限长直载流导线的近旁放置一个矩形导体线框, 该线框在垂直于导线方向上以匀速率 v 向右移动, 求在图示位置处线框中的感应电动势的大小和方向。



分析: 用电磁感应定律 $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$ 求解。式中 Φ 是线框运动至任意位置处时, 穿过线框的磁通量。为此设时刻 t 时, 线框左边距导线的距离为 ξ , 如图所示。 ξ 是时间 t 的函数, 且有 $\frac{d\xi}{dt} = v$ 。在求得线框在任意位置处的电动势 $\varepsilon(\xi)$ 后, 再令 $\xi = d$, 即可得线框在题目所给位置处的电动势。

解: 设顺时针方向为线框回路的正向, 在任意位置处穿过线框的磁通量为:

$$\Phi = \int_0^{l_1} \frac{\mu_0 I l_2}{2\pi(x + \xi)} dx = \frac{\mu_0 I l_2}{2\pi} \ln \frac{\xi + l_1}{\xi}$$

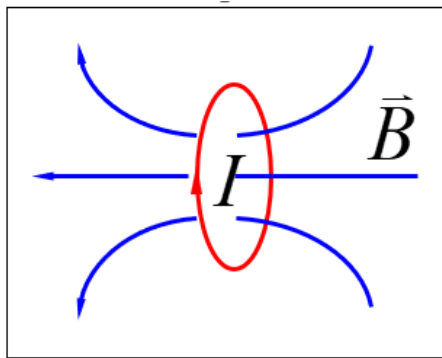
$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 I v l_1 l_2}{2\pi \xi(\xi + l_1)} = \frac{\mu_0 I v l_1 l_2}{2\pi d(d + l_1)}$$

由 $\varepsilon > 0$ 可知, 线框中电动势方向为顺时针方向。



自感电动势 自感

自感现象：由于回路中电流产生的磁通量发生变化，而在自己回路中激发感应电动势的现象叫做**自感现象**，这种**感应电动势**叫做**自感电动势**。



$$\Phi \propto B \propto I \quad L = \frac{\Phi}{I}$$

若线圈有 N 匝

自感:
$$L = N \frac{\Phi}{I}$$

自感电动势：

$$\varepsilon_L = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(LI)}{dt} = -(L \frac{dI}{dt} + I \frac{dL}{dt})$$

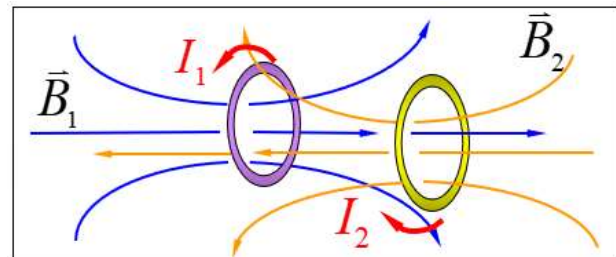
当回路的形状、大小、磁介质及 N 不变时， L =常数。

$$\frac{dL}{dt} = 0 \quad \varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$$

自感:
$$L = -\varepsilon_L / \frac{dI}{dt}$$

互感电动势 互感

由一个回路中**电流变化**而在**另一个回路中**产生**感应电动势**的现象，叫做**互感现象**，这种**感应电动势**叫做**互感电动势**。



互感系数（互感）：

$$M_{12} = M_{21} = M = \frac{\Phi_{21}}{I_1} = \frac{\Phi_{12}}{I_2}$$

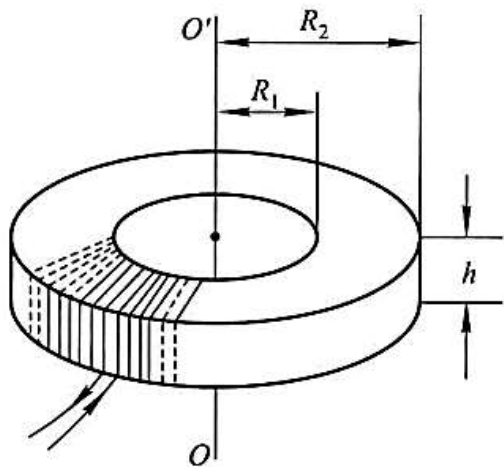
两个线圈形状、大小、匝数、相对位置以及周围的磁介质不变

$$\varepsilon_{21} = -\frac{d\Phi_{21}}{dt} = -M \frac{dI_1}{dt} \quad \varepsilon_{12} = -\frac{d\Phi_{12}}{dt} = -M \frac{dI_2}{dt}$$

互感:
$$M = -\frac{\varepsilon_{21}}{dI_1/dt} = -\frac{\varepsilon_{12}}{dI_2/dt}$$



P351 8-19 截面积为长方形的环形均匀密绕螺绕环，其尺寸如图所示，共有 N 匝，求该螺绕环的自感 L 。



分析：设有电流 I 通过线圈，计算磁场穿过自身回路的总磁通量 Φ ，再用公式 $L = \frac{\Phi}{I}$ 计算自感 L 。

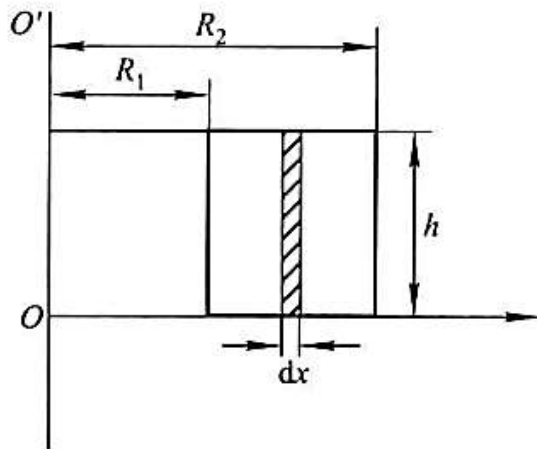
解：设有电流 I 通过线圈，线圈回路呈长方形。由安培环路定理可求得在 $R_1 < r < R_2$ ，范围内的磁场分布为：

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi x} \quad \text{P273 例1}$$

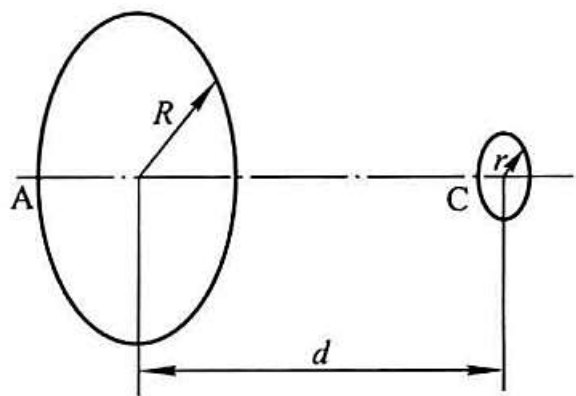
线圈由 N 匝回路构成，所以穿过自身回路的磁链为

$$N\Phi = N \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = N \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 NI}{2\pi x} h dx = \frac{\mu_0 N^2 I h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$



P352 8-24 如图所示，两同轴单匝线圈A、C的半径分别为 R 和 r ，两线圈相距为 d 。若 r 很小，可认为线圈A在线圈C处所产生的磁场是均匀的。求两线圈的互感；若线圈C的匝数为 N 匝，则互感又为多少？



解：设线圈A中有电流 I 通过，它在线圈C所包围的平面内各点产生的磁感强度近似为：

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + d^2)^{3/2}} \quad \text{P261 例1}$$

穿过线圈C的磁通为：

$$\Phi = BS_C = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + d^2)^{3/2}} \pi r^2$$

若线圈C的匝数为 N 匝，
则互感为上述值的 N 倍。

则两线圈的互感为：

$$M = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 \pi r^2 R^2}{2(R^2 + d^2)^{3/2}}$$

